



## 单晶砷化镓的规格

	砷化镓半绝缘性, 无掺杂	砷化镓半导体性 p型和n型
直径	晶片: 从2英寸到4英寸 锭与合成物: 从2英寸到6英寸	
厚度	晶片: 从325微米到750微米 锭与合成物: 从2英寸到6英寸	
掺杂物	-	锌、硅、碲
载子浓度	-	n型 $1 \times 10^{16} - 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ p型 $1 \times 10^{16} - 5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$
晶体取向	(100)、(110)、(111)	
晶向偏离	最高 15°, 如有必要 >15°	
电阻率	$>1 \times 10^7 \Omega \text{ cm}$	$>1 \times 10^{-3} \Omega \text{ cm}$
霍尔迁移率	$>6000 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$	n型 $>1500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ ; p型低
腐蚀坑密度 (EPD)	$<1 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$	液封直拉法 (LEC): $<7 \times 10^4 \text{ cm}^{-2}$ 垂直梯度凝固 (VGF): $<5 \times 10^3 \text{ cm}^{-2}$
表面处理	晶片: 切割/研磨/蚀刻/单面和双面抛光 锭和合成物: 研磨/生长/切割	
平面取向	US SEMI 或 EJ 标准	
包装	标准/Empak/Fluoroware/Fluoroware N2 密封	